

2SC3110

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

高周波広帯域低雑音増幅用 / RF Wide band Low-noise Amplifier

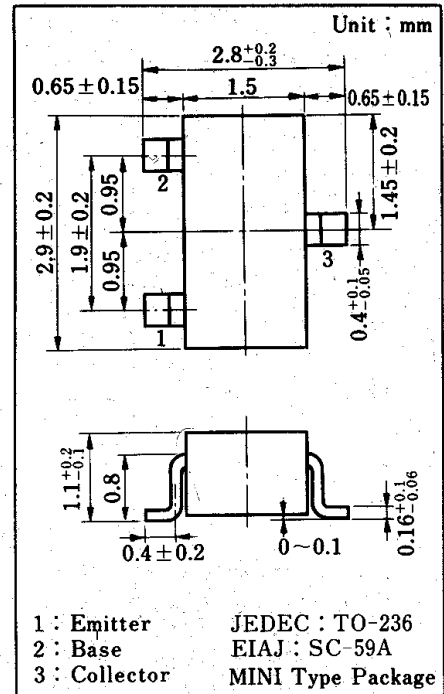
■ 特徴 / Features

- トランジション周波数 f_T が高い。 / High f_T
- ミニ型パッケージのため機器の小型化およびテーピング、マガジン包装による自動挿入が可能。

MINI Type package suitable for small equipment, tape and magazine types for automatic insertion are available.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	15	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	12	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	2.5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	50	mA
コレクタ電流	I_C	30	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C



Marking Symbol : 1U

■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=0$			100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=2\text{ V}, I_C=0$			1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=10\text{ mA}$	40			
トランジション周波数	f_T	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=-10\text{ mA}$		4.5		GHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=0, f=1\text{ MHz}$			1.2	pF
順方向伝達利得	S_{21e}	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=20\text{ mA}, f=0.8\text{ GHz}$	9	12		dB
有能電力利得	GUM	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=20\text{ mA}, f=0.8\text{ GHz}$	12	14		dB
雑音指数	NF	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=5\text{ mA}, f=0.8\text{ GHz}$		1.3	2.5	dB

■ 形名表示記号 / Marking Symbol

